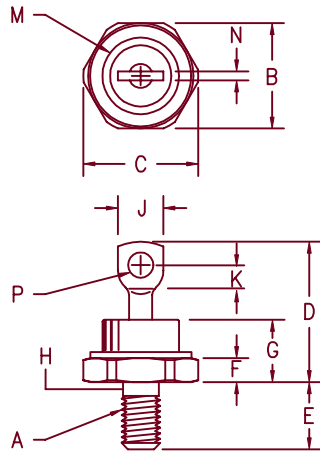


Military Silicon Power Rectifier

1N1184–1N1190, 1N3766–1N3768



Notes:

1. 1/4–28 UNF–3A
2. Full threads within 2 1/2 threads
3. Standard Polarity: Stud is Cathode
Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1
B	.667	.687	16.95	17.44	
C	---	.793	---	20.14	
D	---	1.00	---	25.40	
E	.422	.453	10.72	11.50	
F	.115	.200	2.93	5.08	
G	---	.450	---	11.43	
H	.220	.249	5.59	6.32	2
J	.250	.375	6.35	9.52	
K	.156	---	3.97	---	
M	---	.667	---	16.94	Dia
N	---	.080	---	2.03	
P	.140	.175	3.56	4.44	Dia

D0203AB (D05)

Microsemi Catalog Number		Peak Reverse Voltage
Standard	Reverse	
1N1184	1N1184R	100V
1N1186	1N1186R	200V
1N1188	1N1188R	400V
1N1190	1N1190R	600V
1N3766	1N3766R	800V
1N3768	1N3768R	1000V

- Available in JAN, JANTX, JANTXV
- MIL–PRF–19500/297
- Glass Passivated Die
- Glass to metal seal construction
- 500 Amps surge rating
- V_{RRM} to 1000V

Electrical Characteristics

Average forward current	$I_F(AV)$ 35 Amps	$T_C = 150^\circ C$, half sine wave, $R_{\theta JC} = 0.8^\circ C/W$
Maximum surge current	I_{FSM} 500 Amps	8.3ms, half sine, $T_J = 150^\circ C$
Max I^2t for fusing	I^2t 1100 A^2s	
Max peak forward voltage	V_{FM} 1.40 Volts	$I_{FM} = 110A: 25^\circ C^*$
Max peak forward voltage	V_{FM} 2.3 Volts	$I_{FM} = 500A: 25^\circ C$
Max peak reverse current	I_{RM} 10 μA	$V_{RRM}, T_J = 25^\circ C$
Max peak reverse current	I_{RM} 1.0 mA	$V_{RRM}, T_J = 150^\circ C^*$
Max Recommended Operating Frequency	10 kHz	

*Pulse test: Pulse width 300 μsec , Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	T_{STG}	$-65^\circ C$ to $175^\circ C$
Operating junction temp range	T_J	$-65^\circ C$ to $175^\circ C$
Max thermal resistance	$R_{\theta JC}$	$0.8^\circ C/W$ Junction to Case
Max mounting torque		30 inch pounds maximum
Typical Weight		.5 ounces (14 grams) typical

MILITARY 1N1184–1N1190, 1N3766–1N3768

Figure 1
Typical Forward Characteristics

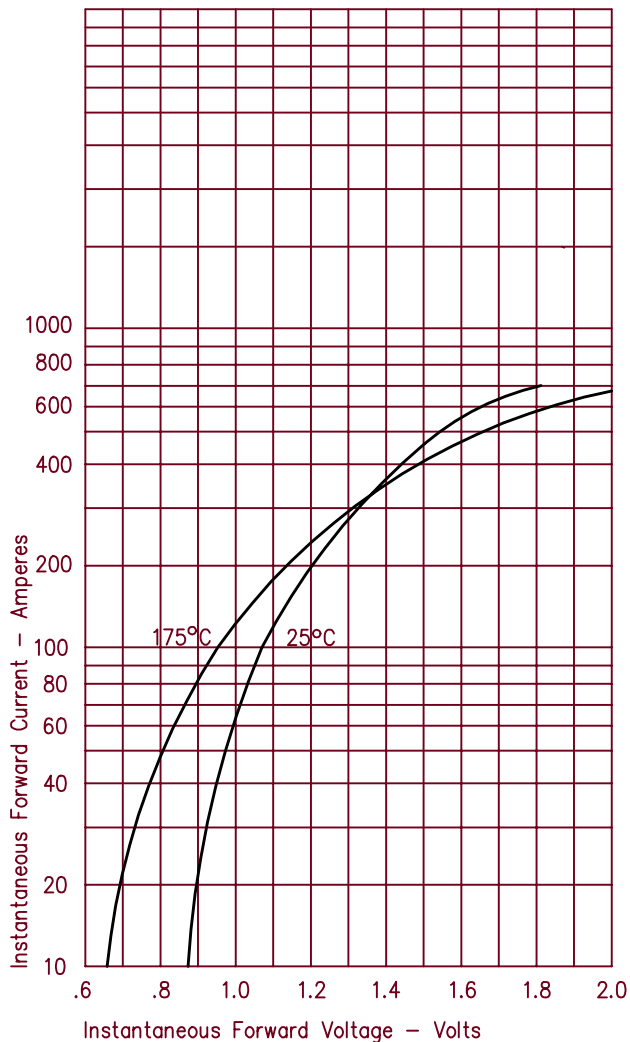


Figure 3
Forward Current Derating

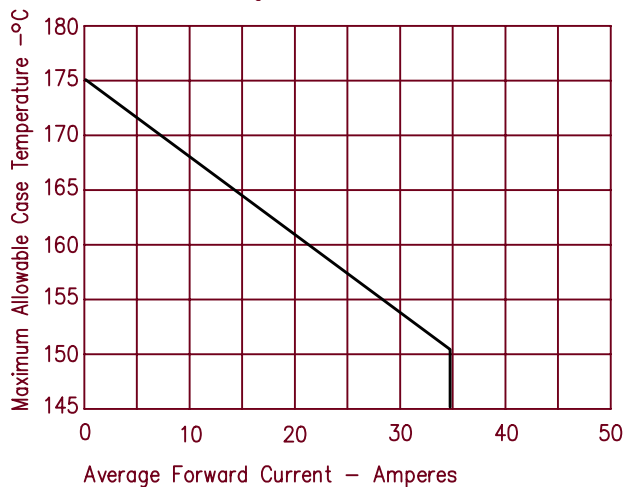


Figure 4
Transient Thermal Impedance

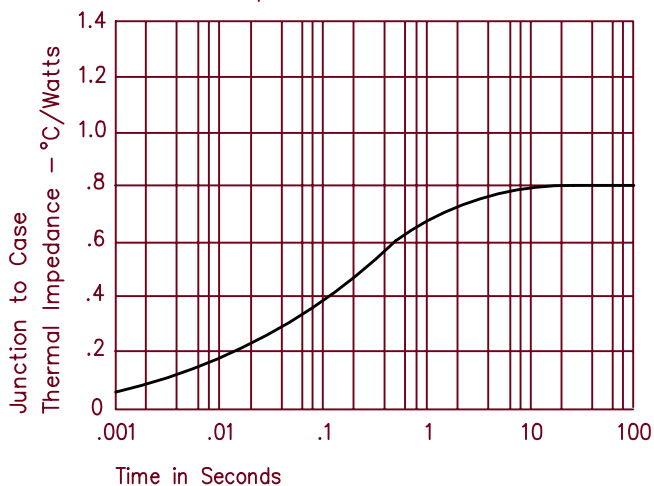
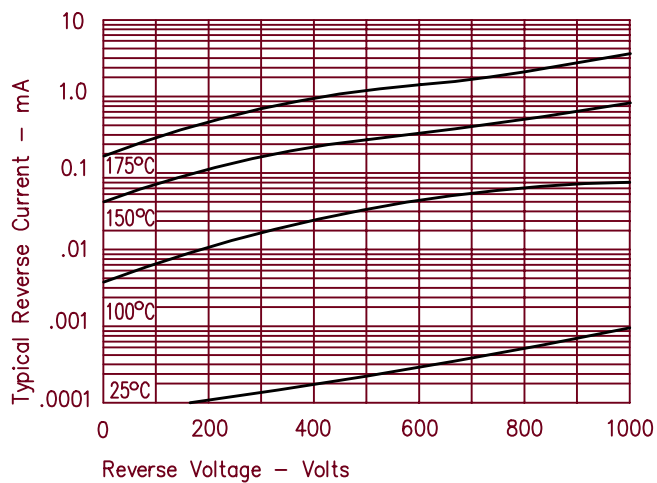


Figure 2
Typical Reverse Characteristics



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9